Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0406U000229

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-01-2006

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мельник Оксана Ярославівна
2. Mel'nyk Oksana Yaroslavivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.18

Назва наукової спеціальності: Фізика і хімія поверхні

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 23-12-2005

Спеціальність за освітою: 7.070101

Місце роботи здобувача: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 20.051.06

Повне найменування юридичної особи: Коломийський інститут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Код за ЄДРПОУ: 25735101

Місцезнаходження: вул. Лисенка, 8, м. Коломия, Коломийський р-н., Івано-Франківська обл., 78200, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.17.27

Тема дисертації:

1. Електронні релаксації радіаційних дефектів при-поверхневого шару кристалів цезій галоїдів та екзоемісія електронів.

2. Electronic relaxations of the radiative defects in the sub-surface layer of caesium halides crystals and exoemission of electrons.

Реферат:

1. Предмет: взаємозв'язок явища екзоелектронної емісії з електронними релаксаціями радіаційних дефектів. Мета: побудова і обґрунтування рекомбінаційної моделі явища екзоелектронної емісії для широкозонних діелектричних кристалів цезій галоїдів. Методи: квантово-механічний. Результати: вперше зроблено оцінки та проведене цілісне дослідження всіх етапів протікання явища екзоемісії для широкозонних діелектричних кристалів цезій галоїдів у межах побудованої релаксаційно-рекомбінаційної моделі; одержано енергетичні спектри екзоелектронів у аналітичному вигляді. Використання: можуть бути використані в наукових дослідженнях, що займаються дефектоскопією поверхні та приповерхневого шару твердих тіл; при викладанні спецкурсів.

2. Object: interrelation of the phenomenon of exoelectron emission with electronic relaxation of radiation defects. Purpose: construction and substantiation of recombination model of the exoelectron emission phenomenon for wide-band dielectric crystals of caesium haloids. Methods: quantum-mechanical. Results: estimations are done first and integral research of all stages of passing of the exoemission phenomenon for wide-band dielectric crystals of caesium haloids is realised within bounds of the built relaxation-recombination model; the energy spectra of exoelectrons are got in the analytical type. Using: can be used in scientific researches that are engaged in defectoscopy of surface and surface layer of solids; at teaching of the special courses.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Галій Павло Васильович
2. Galiy Pavlo Vasylyovych

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.18

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дмитрук Микола Леонтійович
2. Дмитрук Микола Леонтійович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Волошиновський Анатолій Степанович
2. Волошиновський Анатолій Степанович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Остафійчук Богдан Костянтинович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Остафійчук Богдан Костянтинович
Відповідальний за підготовку облікових документів	

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

Юрченко Т.А.